

关键指标

频率: 4.2~5.2GHz
 功率增益: 20dB
 输出功率: 37dBm
 功率附加效率: 38%
 偏置: VD:8V/640mA, Vg:-0.68V
 外形尺寸: 3mm×2.2mm

产品简介

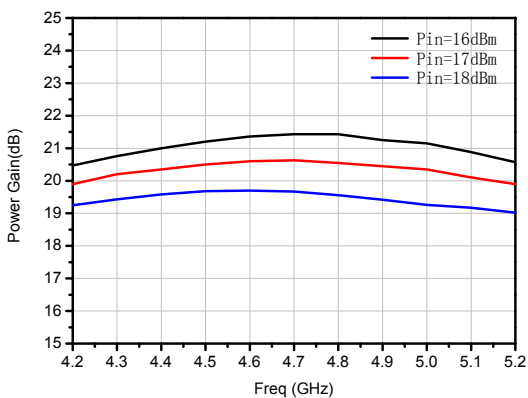
HG134FC 型芯片是一款性能优良的 C 波段大功率放大器。芯片采用双电源供电, 可提供 37dBm 输出功率。该芯片主要应用于收发组件、无线通信等领域。

电性能 ($T_A=25^{\circ}\text{C}$, $V_{ds}=+8\text{V}$, $V_g=-0.68\text{V}$, $I_{ds}=640\text{mA}$, CW)

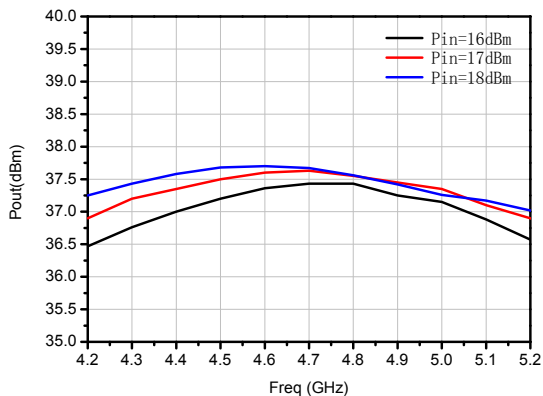
指标	最小值	典型值	最大值
频率 (GHz)	4.2~5.2		
功率增益 (dB)	-	20	-
功率增益平坦度 (dB)	-	± 0.1	-
饱和输出功率 (dBm)	-	37	-
功率附加效率 (%)	-	38	-

典型测试曲线

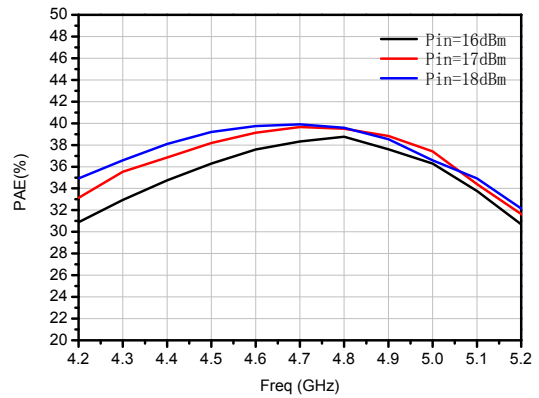
功率增益



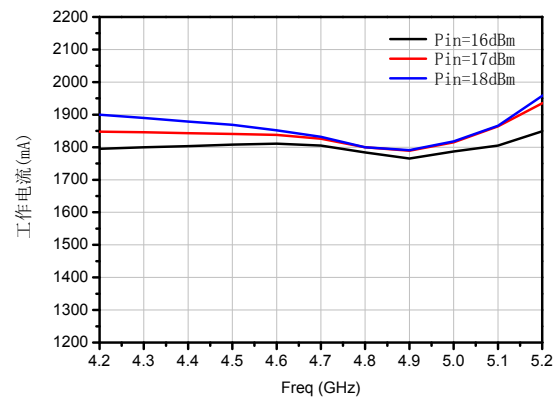
输出功率



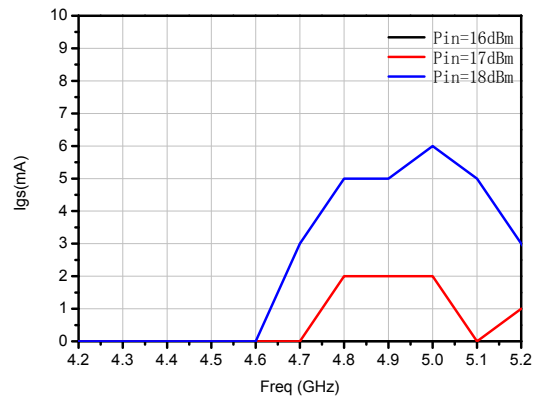
功率附加效率



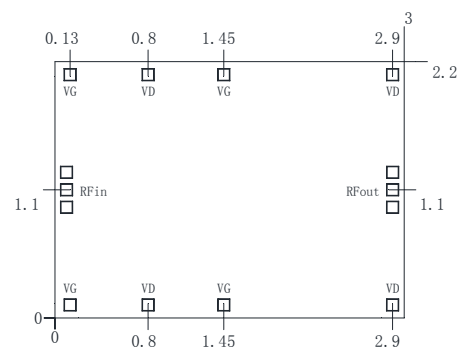
工作电流



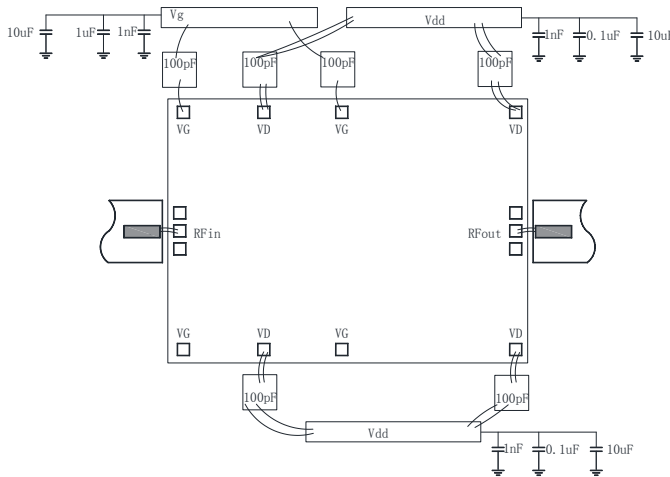
栅电流



外形和端口尺寸 (mm)



推荐装配图



绝对额定最大值

工作电压 Vds	+10V
工作电压 Vdg	+15V
最大输入功率	+28dBm
沟道温度	175℃
烧结温度	300℃
工作温度	-55℃~85℃
存储温度	-65℃~150℃

注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片采用金锡合金烧结，使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，输出端使用 $\Phi 25 \mu\text{m}$ 双金丝键合，建议金丝长度 250~400 μm ；
5. 芯片微波端有隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。